

***НИ ТГУ, г. Томск, Россия.*

5. В.В. Брюханова, В.С. Шаманаев. **Возможности обнаружения слабоконтрастных неоднородностей по лидарным сигналам.** *ИОА СО РАН г. Томск, Россия.*

6. К.А. Криворотов, В.В. Брюханова. **Алгоритм определения интервалов кусочной интерполяции элементов матрицы рассеяния света полидисперсных капельных облаков** *НИ ТГУ, г. Томск, Россия.*

7. В.В. Дёмин, А.С. Козлова. **Методы обработки цифровых голограмм на основе вейвлет преобразования** *НИ ТГУ, г. Томск, Россия.*

8. В.В. Дёмин, Д.В. Каменев. **Алгоритм автоматического расчёта интегральных характеристик объёма с частицами по голографическим данным.** *НИ ТГУ, г. Томск, Россия.*

9. Е.А. Копылов. **Анализ влияния атмосферных аберраций волнового фронта на параметры изображений, регистрируемых на БСВТ.** *ИОА СО РАН, г. Томск, Россия.*

10. И.А. Винеров, Г.И. Кропотов, Д.И. Цыпишка, И.А. Цибизов. **Термоакустический детектор импульсного СВЧ излучения.** *ООО "Тидекс", г. Санкт-Петербург, Россия.*

Секция 5. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ФОТОНИКА

Председатель секции – профессор Войцеховский Александр Васильевич

Подсекция 5.1. Нанопотоника и наноплазмоника: материалы, технология, применение

Руководитель – профессор Войцеховский Александр Васильевич.

6 октября 2015, вторник, 14:00 –18:00, Конференцзал НБ ТГУ. (пр. Ленина, 34,а)

1. И.И. Ижнин***, Е.И. Фицыч*, А.В. Войцеховский**, А.Г. Коротаев**, К.Д. Мынбаев*****, В.С. Варавин*****, С.А. Дворецкий*****, Н.Н. Михайлов*****, М.В. Якушев*****, А.Ю. Бончик*****, Г.В. Савицкий*****, П. Озга*****, З. Свёнтек*****. **Электрофизические и оптические исследования дефектной структуры МЛЭ пленок CdHgTe.** *НПП "Карат", г. Львов, Украина, **ТГУ, г. Томск, ***ФТИ, г. Санкт-Петербург, ****ИТМО, г. Санкт-Петербург, *****ИФП СО РАН, г. Новосибирск, Россия, ****ИПММ НАНУ, г. Львов, Украина, ****ИМИМ ПАН, г. Краков, Польша. *(приглашенный доклад)*

2. А.А. Гузев, В.М. Базовкин, А.П. Ковчавцев, А.В. Царенко, З.В.Панова, М.В. Якушев Д.В. Марин, В.С. Варавин, В.В. Васильев, С.А. Дворецкий, И.В. Сабина, Ю.Г.Сидоров, Г.Ю. Сидоров. **Гетероструктуры CdHgTe/Si для тепловизоров работающих при повышенных температурах.** *ИФП СО РАН, г. Новосибирск, Россия. (приглашенный доклад)*

3. А.Р. Туктамышев*, В.А. Тимофеев*, А.И. Никифоров***, В.И. Машанов*, М.Ю. Есин*, С.А. Тийс*. **Формирование методом МЛЭ самоорганизующихся наноструктур Ge-Si-Sn на Si(100) для использования в оптоэлектронике и фотонике.** *ИФП СО РАН, г. Новосибирск, **ТГУ, г. Томск, Россия. *(приглашенный доклад)*

4. М.Ю. Есин*, А.И. Никифоров***, В.А. Тимофеев*, В.И. Машанов*, А.Р. Туктамышев*, О.П. Пчеляков***. **Анализ дефектности пленок GeSn и GeSiSn полученных методом МЛЭ на подложках Si(100).** *ИФП СО РАН, г. Новосибирск, **ТГУ, г. Томск, Россия.

5. И.И. Ижнин***, Е.И. Фицыч*, А.В. Войцеховский**, А.Г. Коротаев**, К.Д. Мынбаев*****, В.С. Варавин*****, С.А. Дворецкий*****, Н.Н. Михайлов*****, М.В. Якушев*****, А.Ю. Бончик*****, Г.В. Савицкий*****. **Долговременная стабильность CdHgTe N⁺-N-структур, сформированных ионным травлением.** *НПП "Карат", г. Львов, Украина, **ТГУ, г. Томск, ***ФТИ, г. Санкт-Петербург, ****ИТМО, г. Санкт-Петербург, *****ИФП СО РАН, г. Новосибирск, Россия, ****ИПММ НАНУ, г. Львов, Украина.

6. А.В. Войцеховский, А.П. Коханенко, К.А. Лозовой. **Расчет критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту в материальной системе Ge_xSi_{1-x}/Si(100).** *ТГУ, г. Томск, Россия.*